



BD138: Transistor PNP Epitaxial Silicon 60V 1A



Descripción

Nombre: TRANSISTOR PNP EPITAXIAL SILICON Complemento del BD137 **Referencia:** BD138

- Polaridad del transistor: PNP
- Configuración: Single
- Corriente CC máxima de colector: 1A
- Máx. voltaje VCEO colector-emisor: 60V
- Tensión VCBO colector-base: 60V
- Voltaje VEBO emisor-base: 5V
- Voltaje de saturación colector-emisor: 500mV
- Dp - Disipación de potencia: 1.25W
- Ganancia de corriente continua (hFE): de 40 a 160.
- Temperatura de trabajo: desde 0°C hasta 150°C

Marca: ASI **Empaque:** TO-126 **Precio por:** Unidad **Ficha Técnica:** [BD138 por On semiconductor](#)

Información del producto

Descripción: TRANSISTOR PNP EPITAXIAL SILICON. Marca: ASI. Referencia: BD138. El BD138 es un transistor bipolar PNP de potencia media, diseñado para aplicaciones de amplificación y conmutación en circuitos de audio y aplicaciones generales.

Precio: \$2.100 IVA INCLUIDO

SKU: 9-5-163

Categorías: [SEMICONDUCTORES](#), [TRANSISTORES Y REGULADORES](#)

Etiquetas: [0090005000163](#), [9-5-163](#), [ASI](#), [BD138](#), [pinout](#), [SEMICONDUCTORES](#), [Through Hole](#), [TRANSISTOR PNP EPITAXIAL SILICON](#), [TRANSISTORES Y REGULADORES](#)

